

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 1 区分

【発行日】令和 3 年 11 月 18 日 (2021.11.18)

【公開番号】特開 2020-63186 (P2020-63186A)

【公開日】令和 2 年 4 月 23 日 (2020.4.23)

【年通号数】公開・登録公報 2020-016

【出願番号】特願 2019-161167 (P2019-161167)

【国際特許分類】

C 3 0 B 29/36 (2006.01)

C 3 0 B 25/20 (2006.01)

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

C 2 3 C 16/32 (2006.01)

G 0 1 N 21/956 (2006.01)

G 0 1 N 21/88 (2006.01)

【F I】

C 3 0 B 29/36 A

C 3 0 B 25/20

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/66 N

C 2 3 C 16/32

G 0 1 N 21/956 A

G 0 1 N 21/88 K

【手続補正書】

【提出日】令和 3 年 10 月 7 日 (2021.10.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 面における帯状積層欠陥の占める面積が特定されている S i C 基板と、
前記 S i C 基板の前記第 1 面に積層されたエピタキシャル層と、を備え、
前記 S i C 基板の前記第 1 面における帯状積層欠陥の占める面積が、前記 S i C 基板の
第 1 面の面積の 1 / 4 以下である、S i C エピタキシャルウェハ。

【請求項 2】

前記 S i C 基板の第 1 面における帯状積層欠陥の位置が特定された、請求項 1 に記載の
S i C エピタキシャルウェハ。

【請求項 3】

前記帯状積層欠陥の密度が、 10 個 cm^{-2} 以下である、請求項 1 に記載の S i C エピ
タキシャルウェハ。